

772

硅 PNP 外延平面晶体管芯片(4 " )

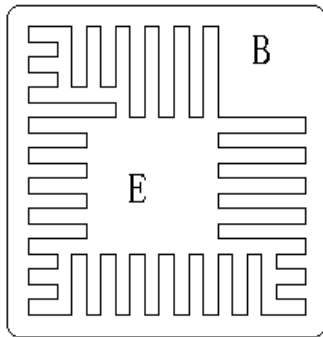
■用途:

- \*中等功率放大器
- \*中速开关应用

■特征:

- \*集电极电流: 3A
- \*有效图形数: 5800

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	1130 μ m × 1130 μ m
压焊区尺寸	基 区 335 μ m × 335 μ m 发射区 390 μ m × 390 μ m
芯片厚度	225 ± 10 μ m
锯片槽宽度	70 μ m
金属层	正面: Al 2.7 ± 0.2 μ m 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	I <sub>C</sub> = -0.1 mA, I <sub>E</sub> = 0	-40		V
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	I <sub>C</sub> = -1 mA, I <sub>B</sub> = 0	-30		V
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	I <sub>B</sub> = -0.1 mA, I <sub>C</sub> = 0	-6		V
集电极-基极截止电流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CB</sub> = 0.8 BV <sub>CBO</sub> , I <sub>E</sub> = 0		-0.5	μ A
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -4V, I <sub>C</sub> = 0		-0.5	μ A
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	V <sub>CE</sub> = -2V, I <sub>C</sub> = -1A	100	400	
集电极-发射极饱和电压	V <sub>CES</sub>	I <sub>C</sub> = -2A, I <sub>B</sub> = -0.2A		-0.5	V
基极-发射极饱和电压	V <sub>BES</sub>	I <sub>C</sub> = -2A, I <sub>B</sub> = -0.2A		-1.2	V